

日程表 (会場別) 1

青山学院大学

会場名	収容人数	3月17日(月)		3月18日(火)		3月19日(水)		3月20日(木)		
		午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	
D (D棟)	D1 D107	81	チュートリアル「スピントロニクス」の基礎	4.6 レーザー分光応用・計測	11.1 基礎物性	11.1 基礎物性	4.7 レーザー・プロセス	4.7 レーザー・プロセス	4.7 レーザー・プロセス	
	D2 D113	144			15.2 II-VI 族結晶	環境・エネルギー教育を考える	16.2 プロセス技術・デバイス	16.1 基礎物性・評価		
	D3 D114	144	チュートリアル「超伝導体の電磁現象と磁束ピンニングの基礎」	評価する(はかる)一超伝導材料の評価技術基礎から応用まで	15.1 バルク結晶成長	東電福島原発事故から三年を経て～現状と復興への技術開発について	レーザー点火による省エネルギーの技術革新をめざして(燃焼学会、自動車技術会共催)	14.1 探索的材料物性	14.1 探索的材料物性	
	D4 D115	81		11.5 接合、回路作製プロセスおよびデジタル応用	11.3 臨界電流、超伝導パワー応用	11.2 薄膜、厚膜、テープ作製プロセスおよび結晶成長		11.2 薄膜、厚膜、テープ作製プロセスおよび結晶成長		
	D5 D207	81	チュートリアル「粒子・重イオン輸送計算コードPHITS入門」	17.2 構造制御・プロセス	11.4 アナログ応用および関連技術	11.4 アナログ応用および関連技術	6.6 プローブ顕微鏡	6.6 プローブ顕微鏡	6.6 プローブ顕微鏡	
	D6 D209	81	6.2 カーボン系薄膜	6.2 カーボン系薄膜	6.2 カーボン系薄膜	6.2 カーボン系薄膜	6.4 薄膜新材料	6.4 薄膜新材料	6.4 薄膜新材料	
	D7 D214	144	応用物理とMathematica	応用物理とMathematica	14.5 化合物太陽電池	14.5 化合物太陽電池	14.5 化合物太陽電池	14.5 化合物太陽電池		
	D8 D215	144	チュートリアル「プラスマプロセス速度論解析の基礎とCVD/ALDへの展開」	光を用いた構造ヘルスマニタリング技術	13.2 絶縁膜技術	13.2 絶縁膜技術	14.3 電子デバイス・プロセス技術	14.3 電子デバイス・プロセス技術	14.3 電子デバイス・プロセス技術	
	D9 D315	144	チュートリアル「レーザーディスプレイのためのスペックルの基礎と除去方式」	結晶シリコン太陽電池の最新線	Flexible Electronics	Flexible Electronics	13.1 基礎物性・表面界面現象・シミュレーション	13.1 基礎物性・表面界面現象・シミュレーション	13.1 基礎物性・表面界面現象・シミュレーション	
	D10 D316	144	4.1 量子光学・原子光学	4.1 量子光学・原子光学	6.1 強誘電体薄膜	フェロエレクトリック・イノベーション材料からデバイスまで	6.1 強誘電体薄膜	6.1 強誘電体薄膜		
E (E棟)	E1 E101	385	ナノエレクトロニクスの新展開と国際連携	総合科学技術会議議員久間和生氏特別講演 ナノエレクトロニクスの新展開と国際連携	Developments and Challenges for Resistance Change Memories Technology (抵抗変化メモリ技術の発展及び課題)	Developments and Challenges for Resistance Change Memories Technology (抵抗変化メモリ技術の発展及び課題)		SSDM 特別シンポジウム(固体エレクトロニクス研究の最新線)		
	E2 E102	303	17. ナノカーボン(シュート口頭講演付ポスター講演)	第14回応用物理学学会業績賞(研究業績)受賞記念講演 業績賞・研究分野業績講演奨励賞贈呈式	17.3 新機能探索・基礎物性評価 17.2 構造制御・プロセス	17.1 成長技術	17.3 新機能探索・基礎物性評価 17.1 成長技術	17.4 デバイス応用	17.4 デバイス応用	
	E3 E103	303		12.4 有機EL・トランジスタ	12.4 有機EL・トランジスタ	分子制御技術による新構造・新機能の創出～上田裕清先生追悼シンポジウム～	12.4 有機EL・トランジスタ	12.4 有機EL・トランジスタ	12.4 有機EL・トランジスタ	
	E4 E104	210	3.4 計測光学	3.4 計測光学	3.4 計測光学	特別シンポジウム「応用物理分野の女性達～第2回フォトニクス編～」	シリコンテクノロジー分科会論文賞および奨励賞記念講演	地産地消のエネルギーシステム		
	E5 E105	210		15.6 IV 族系化合物	15.6 IV 族系化合物	15.6 IV 族系化合物	12.1 作製・構造制御	12.1 作製・構造制御	12.1 作製・構造制御	
	E6 E106	210	3.6 生体・医用光学	3.6 生体・医用光学	12.3 機能材料・萌芽的デバイス		12.3 機能材料・萌芽的デバイス	特別シンポジウム「産学連携の新パラダイム～日本のモノ作りの再生に向けて～」	12.3 機能材料・萌芽的デバイス	
	E7 E201	357	10. スピントロニクスマテリアル(シュート口頭講演付ポスター講演)	10.1 新物質創成(酸化物・ホイスラー・金属磁性体等)	10.1 新物質創成(酸化物・ホイスラー・金属磁性体等)	スピン流物理の新展開	10.2 スピントロニクス・スピントロニクス・回路・測定技術 10.4 半導体・有機・量子スピントロニクス	10.2 スピントロニクス・スピントロニクス・回路・測定技術 10.4 半導体・有機・量子スピントロニクス	10.3 GMR・TMR・磁気記録技術	10.3 GMR・TMR・磁気記録技術
	E8 E202	303	5.4 光ファイバー	5.4 光ファイバー	6.3 酸化物エレクトロニクス	6.3 酸化物エレクトロニクス	6.3 酸化物エレクトロニクス	6.3 酸化物エレクトロニクス	6.3 酸化物エレクトロニクス	
	E9 E203	303		自動車産業を支えるエレクトロニクス	プラズマエレクトロニクス分科会招待講演 プラズマエレクトロニクス分科会海外研究者招待講演	12.5 有機太陽電池	12.5 有機太陽電池	12.5 有機太陽電池	12.5 有機太陽電池	
	E10 E204	210	合同セッションK ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス	合同セッションK ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス	合同セッションK ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス	合同セッションK ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス	合同セッションK ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス	ワイドバンドギャップ酸化物半導体による新しい機能の創成		
	E11 E205	210	15.7 エピタキシーの基礎 15.3 III-V 族エピタキシャル結晶	15.3 III-V 族エピタキシャル結晶	15.3 III-V 族エピタキシャル結晶	14.4 光物性・発光デバイス	14.4 光物性・発光デバイス	14.4 光物性・発光デバイス	14.4 光物性・発光デバイス	
	E12 E206	210		放射線・粒子シミュレータの最新動向	16.3 シリコン系太陽電池	16.3 シリコン系太陽電池	16.3 シリコン系太陽電池	16.3 シリコン系太陽電池	「割れないガラス」の最先端研究動向と新たな展開	
	E13 E301	385	15.4 III-V 族窒化物結晶	15.4 III-V 族窒化物結晶	15.4 III-V 族窒化物結晶	15.4 III-V 族窒化物結晶	15.4 III-V 族窒化物結晶	窒化物半導体特異構造の科学～成長・作製と新機能の発現～	15.4 III-V 族窒化物結晶	
	E14 E302	303	12.7 医用工学・バイオチップ	12.7 医用工学・バイオチップ	13.3 Siプロセス・配線・MEMS・集積化技術	13.3 Siプロセス・配線・MEMS・集積化技術	13.3 Siプロセス・配線・MEMS・集積化技術	13.3 Siプロセス・配線・MEMS・集積化技術	13.3 Siプロセス・配線・MEMS・集積化技術	
	E15 E303	303	14.2 超薄膜・量子ナノ構造	14.2 超薄膜・量子ナノ構造	14.2 超薄膜・量子ナノ構造	ナノバイオマテリアル研究の最新線	12.7 医用工学・バイオチップ	12.7 医用工学・バイオチップ		
	E16 E304	210		4.2 フォトニックナノ構造・現象	4.2 フォトニックナノ構造・現象	4.2 フォトニックナノ構造・現象	12.2 評価・基礎物性	12.2 評価・基礎物性	12.2 評価・基礎物性	
	E17 E305	210		4.5 テラヘルツ全般	4.5 テラヘルツ全般	4.5 テラヘルツ全般	12.6 ナノバイオテクノロジー	12.6 ナノバイオテクノロジー	12.6 ナノバイオテクノロジー	
	E18 E307	210		4.3 レーザー装置・材料	4.3 レーザー装置・材料	4.3 レーザー装置・材料	17.1 成長技術	17.1 成長技術	17.2 構造制御・プロセス 17.4 デバイス応用	

日程表 (会場別) 2

青山学院大学

会場名	収容人数	3月17日(月)		3月18日(火)		3月19日(水)		3月20日(木)		
		午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	
F (F棟)	F1 F201	81	8.3 プラズマ成膜・表面処理	2.2 検出器開発	7.1 X線技術		2.1 放射線物理一般・検出器基礎	2.2 検出器開発	2.2 検出器開発	
	F2 F204	81		8.2 プラズマ診断・計測		7.3 リソグラフィ	8.6 プラズマ現象・新応用・融合分野	8.6 プラズマ現象・新応用・融合分野	2.3 放射線応用・発生装置・新技術	
	F3 F301	81	7.5 ビーム・光励起表面反応 7.8 ビーム応用一般・新技術	8.1 プラズマ生成・制御		7.4 ナノインプリント		8.5 プラズマナノテクノロジー		
	F4 F304	81	7.6 イオンビーム一般	7.6 イオンビーム一般	1.1 応用物理一般・学際領域		1.3 新技術・複合新領域	1.4 エネルギー変換・貯蔵 1.5 資源・環境	1.6 磁場応用	
	F5 F305	81		7.7 微小電子源	7.2 電子顕微鏡、評価、測定、分析	1.9 超音波	1.7 計測技術	1.8 計測標準		
	F6 F306	81	3.1 光学基礎・光学新領域	3.1 光学基礎・光学新領域	15.5 IV族結晶、IV-IV族混晶	15.5 IV族結晶、IV-IV族混晶	8.4 プラズマエッチング	8.4 プラズマエッチング		
	F7 F307	144	4.4 超高速・高強度レーザー	4.4 超高速・高強度レーザー	4.4 超高速・高強度レーザー	プラズマエレクトロニクス賞授賞式 21世紀グラフェン産業を支えるプラズマプロセスの現状と展望	6.5 表面物理・真空	真空の制約を超える：電子やイオンを用いた分析法の実環境測定への挑戦	6.5 表面物理・真空	
	F8 F308	144	多元化合物の多様な機能性と評価、応用の新展開 ICTMC-19に向けて	多元化合物の多様な機能性と評価、応用の新展開 ICTMC-19に向けて	5.3 光制御	フロンティアを標榜する分極反転デバイス	5.3 光制御	5.3 光制御	5.3 光制御	
	F9 F401	81		5.2 光記録/表示/照明	5.1 半導体レーザー・発光/受光素子	5.1 半導体レーザー・発光/受光素子		15.8 結晶評価、不純物、結晶欠陥		
	F10 F406	81	9.5 新機能材料・新物性	9.5 新機能材料・新物性	3.3 機器・デバイス光学	3.5 情報光学	3.2 材料光学		13.5 Si-English Session	
	F11 F407	144	9.3 ナノエレクトロニクス	9.3 ナノエレクトロニクス	9.2 ナノワイヤ・ナノ粒子	9.2 ナノワイヤ・ナノ粒子	9.4 熱電変換	9.4 熱電変換	9.1 誘電材料・誘電体	
	F12 F408	144	3.7 近接場光学	3.7 近接場光学	3.7 近接場光学	3.7 近接場光学	13.4 デバイス/集積化技術	13.4 デバイス/集積化技術	13.4 デバイス/集積化技術	
PA (アリーナ)	PA1 PA12	ポスターセッション	4.2 フォトニックナノ構造・現象 4.5 テラヘルツ全般 4.6 レーザー分光応用・計測 16.3 シリコン系太陽電池	[前半] 10. スピントロニクス マグネティクス	1.2 教育 7.1 X線技術 7.3 リソグラフィ 7.6 イオンビーム一般 12.2 評価・基礎物性 12.5 有機太陽電池	[前半] 3.1 光学基礎・光学新領域 3.4 計測光学 4.3 レーザー装置・材料 4.4 超高速・高強度レーザー 4.7 レーザー・プロセス セッティング 8.2 プラズマ診断・計測 8.4 プラズマエッチング 8.6 プラズマ現象・新 応用・融合分野 8.3 プラズマ成膜・表 面処理 8.5 プラズマナノテ クノロジー 9.2 ナノワイヤ・ナ ノ粒子	2. 放射線 3.7 近接場光学 8.1 プラズマ生成・制 御 8.3 プラズマ成膜・表 面処理 8.5 プラズマナノテ クノロジー 9.2 ナノワイヤ・ナ ノ粒子	[後半] 1.1 応用物理一般・学 際領域 1.3 新技術・複合新領 域 1.4 エネルギー変換・ 貯蔵 1.6 磁場応用 1.7 計測技術 1.8 計測標準 1.9 超音波 12.3 機能材料・萌芽 的デバイス	6.4 薄膜新材料	・1講演につき、たて 180cm、よこ90cm のパネルが用意されて います。予め講演番号、 講演題目、所属、氏名 を記入した用紙(たて 15cm、よこ85cm) を各自が用意し、これ をパネル上部に取り付 けてください。 ・次にパネルに、各自 が用意したポスター、 図表、写真などを、適 宜レイアウト(例えば 研究目的、研究方法、 研究成果といった順 に)して掲示してくだ さい。
	PG (G棟2階)		PG1 PG12	12.4 有機EL・トラン ジスタ 15.5 IV族結晶、IV-IV 族混晶 15.6 IV族系化合物	[前半] 17. ナノカーボン	3.5 情報光学 3.6 生体・医用光学 12.1 作製・構造制御 12.6 ナノバイオテ クノロジー 12.7 医用工学・バイ オチップ 14.4 光物性・発光デ バイス	[前半] 7.2 電子顕微鏡、評価、 測定、分析 14.2 超薄膜・量子ナ ノ構造 14.3 電子デバイス・ プロセス技術 14.5 化合物太陽電池 15.2 II-VI族結晶 15.3 III-V族エビタキ シャル結晶 15.7 エピタキシーの 基礎	6.2 カーボン系薄膜 11. 超伝導 14.1 探索的材料物性 15.1 バルク結晶成長 15.8 結晶評価、不純 物、結晶欠陥	[後半] 9.1 誘電材料・誘電体 13.2 総論技術 13.3 Siプロセス・配 線・MEMS・集積化技 術 13.5 Si-English Session	15.4 III-V族窒化物結 晶